EasyPACK™ Modul with TRENCHSTOP™ 5 H5 IGBT und NTC

Eigenschaften


Typical appearance

- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 650 V
  - $I_{C\ nom}$ = 35 A / I_{CRM} = 70 A
  - Trench IGBT 5
  - Niedrige Schaltverluste
  - Erhöhte Sperrspannungsfestigkeit auf 650 V
- Mechanische Eigenschaften
  - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern
  - Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
  - Kompaktes Design
  - Lötverbindungstechnik

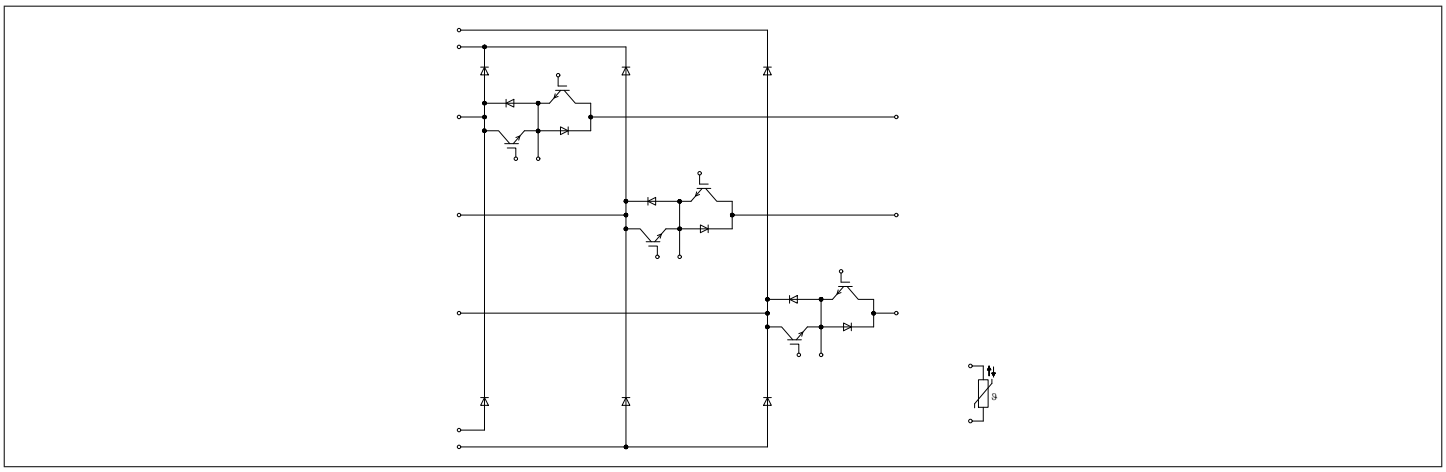
Potenzielle Anwendungen

- USV-Systeme
- Schnellladesäulen
- Motorantriebe

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**IGBT, T1-T6**	3
3	**Diode, D1-D6**	5
4	**Diode, D7-D12**	5
5	**NTC-Widerstand**	6
6	**Kennlinien**	7
7	**Schaltplan**	12
8	**Gehäuseabmessungen**	13
9	**Modul-Label-Code**	14
	Änderungshistorie	15
	Disclaimer	16

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	2.5	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			20		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter		2.4		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter		3.9		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder	*F*		40		80	N
Gewicht	*G*			39		g

Anmerkung: Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.

2 IGBT, T1-T6

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	650	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			35	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 65 °C	25	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		70	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 20 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.32	1.67	V
			T_{vj} = 125 °C		1.39		
			T_{vj} = 150 °C		1.41		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 0.35 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		3.85	4.60	5.35	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 300 V			0.152		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			1.94		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.007		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			0.012	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 20 A, V_{CC} = 350 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 6.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.016		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.017		
			T_{vj} = 150 °C		0.017		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 20 A, V_{CC} = 350 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 6.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.004		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.005		
			T_{vj} = 150 °C		0.006		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 20 A, V_{CC} = 350 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 7.5 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.090		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.110		
			T_{vj} = 150 °C		0.120		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 20 A, V_{CC} = 350 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 7.5 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.018		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.052		
			T_{vj} = 150 °C		0.073		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 20 A, V_{CC} = 350 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 6.2 Ω, di/dt = 2260 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.39		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.49		
			T_{vj} = 150 °C		0.507		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 20 A, V_{CC} = 350 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 7.5 Ω, dv/dt = 7200 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.14		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.31		
			T_{vj} = 150 °C		0.365		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			2.12		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

3 Diode, D1-D6

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	650	V
Dauergleichstrom	I_F			30	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		60	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	90	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	82	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 30 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.60	2.00	V
			T_{vj} = 125 °C		1.55		
			T_{vj} = 150 °C		1.52		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			2.48		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

4 Diode, D7-D12

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Implementierter Durchlassstrom	I_{FN}			50	A
Dauergleichstrom	I_F			20	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		100	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	220	A^2s
			T_{vj} = 175 °C	200	

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 20 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.30	1.50	V
			T_{vj} = 125 °C		1.18		
			T_{vj} = 175 °C		1.10		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 350 V, I_F = 20 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2260 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		40.9		A
			T_{vj} = 125 °C		53.1		
			T_{vj} = 175 °C		62		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 350 V, I_F = 20 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2260 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.27		µC
			T_{vj} = 125 °C		4.36		
			T_{vj} = 175 °C		5.6		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 350 V, I_F = 20 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 2260 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.5		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.08		
			T_{vj} = 175 °C		1.48		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			1.46		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: $T_{vj\,op}$ > 150°C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

5 NTC-Widerstand

Tabelle 9 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

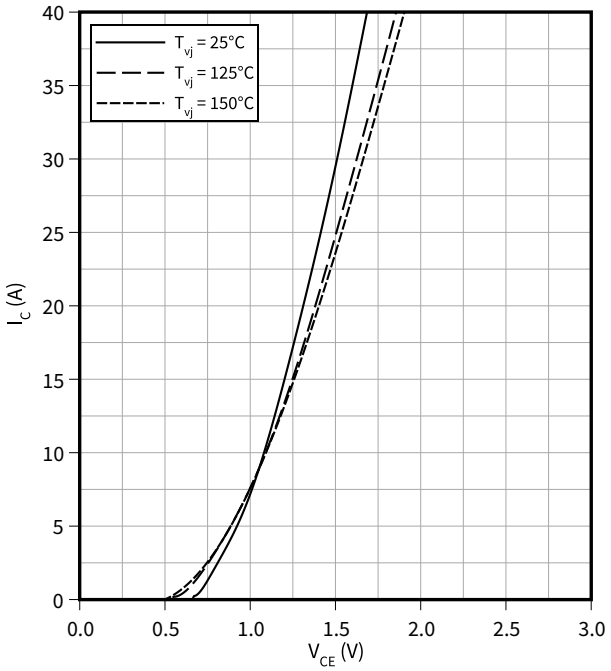
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

6 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, T1-T6

$I_C = f(V_{CE})$

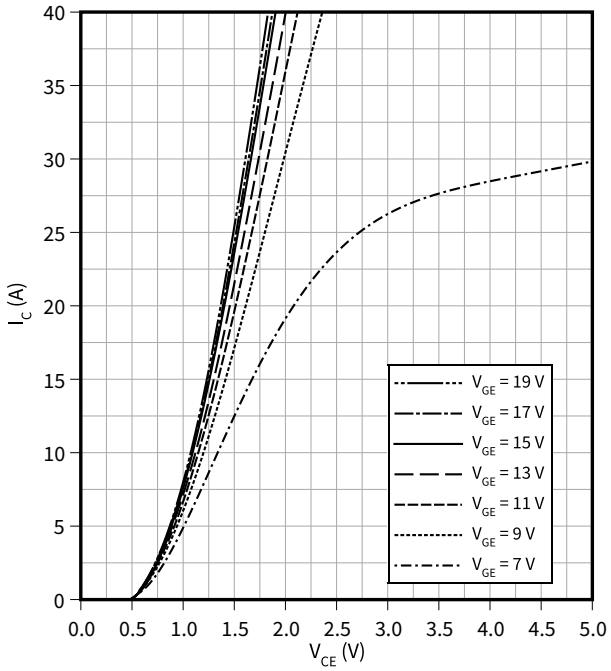
V_{GE} = 15 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, T1-T6

$I_C = f(V_{CE})$

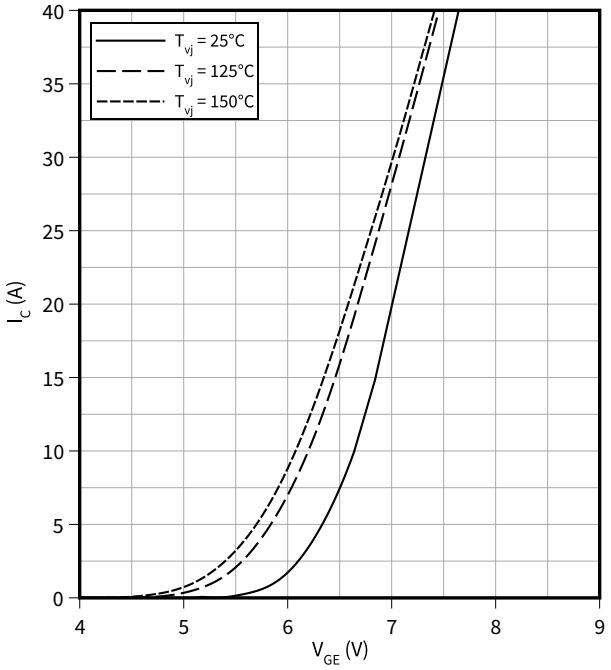
T_{vj} = 150 °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, T1-T6

$I_C = f(V_{GE})$

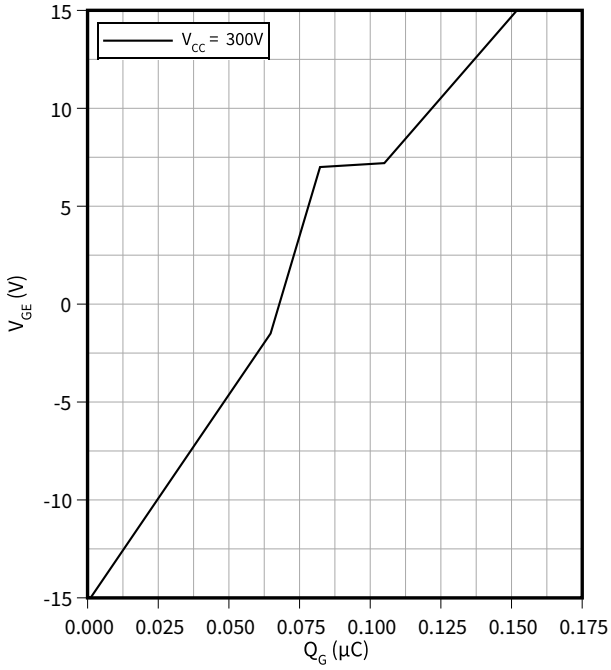
V_{CE} = 20 V



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, T1-T6

$V_{GE} = f(Q_G)$

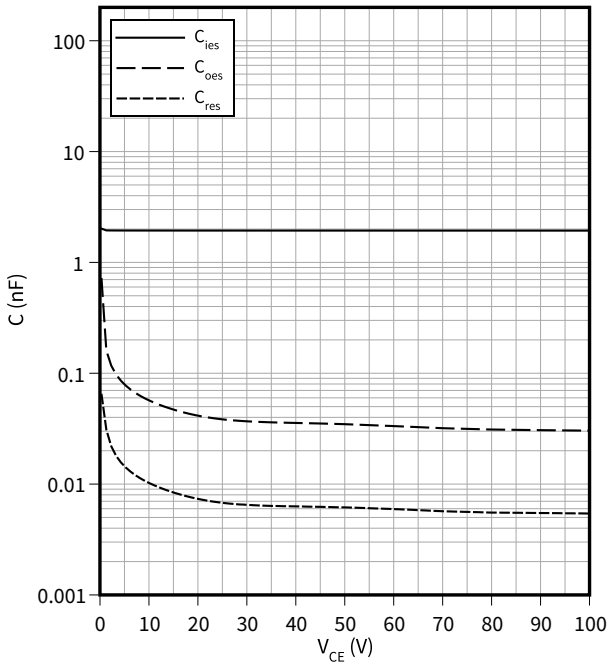
I_C = 35 A, T_{vj} = 25 °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, T1-T6

$C = f(V_{CE})$

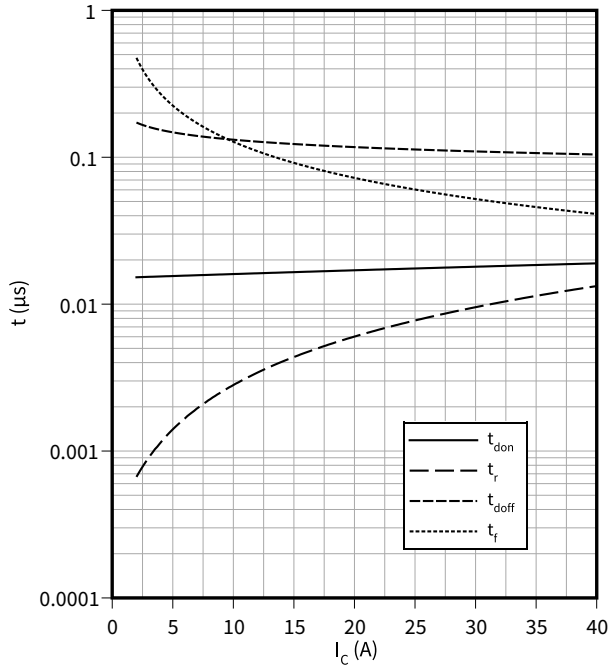
$f = 100$ kHz, $V_{GE} = 0$ V, $T_{vj} = 25$ °C



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1-T6

$t = f(I_C)$

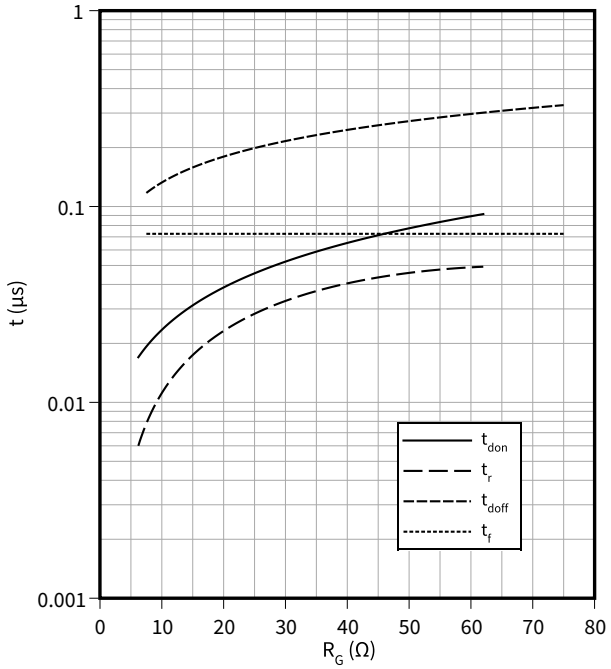
$R_{Goff} = 7.5\ \Omega$, $R_{Gon} = 6.2\ \Omega$, $V_{CC} = 350$ V, $V_{GE} = -15 / 15$ V, $T_{vj} = 150$ °C



Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1-T6

$t = f(R_G)$

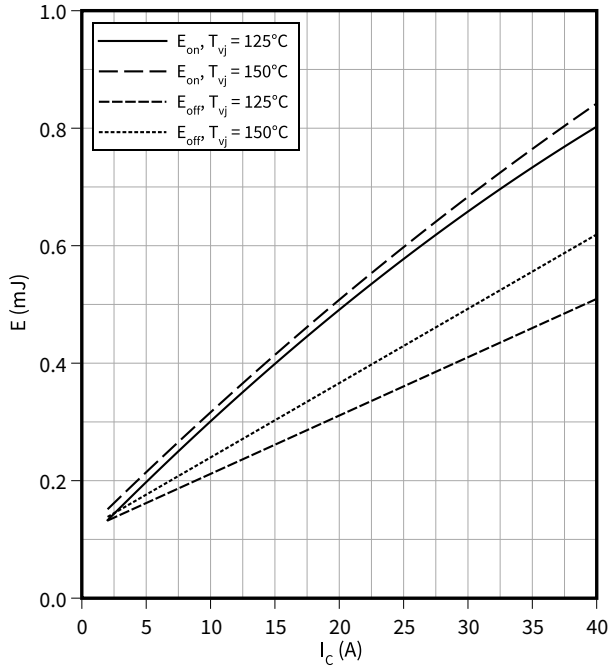
$I_C = 20$ A, $V_{CC} = 350$ V, $V_{GE} = -15 / 15$ V, $T_{vj} = 150$ °C



Schaltverluste (typisch), IGBT, T1-T6

$E = f(I_C)$

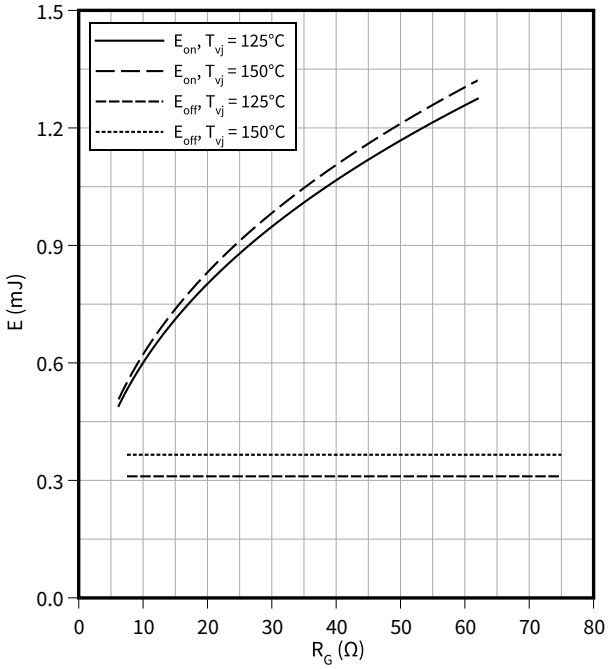
$R_{Goff} = 7.5\ \Omega$, $R_{Gon} = 6.2\ \Omega$, $V_{CC} = 350$ V, $V_{GE} = -15 / 15$ V



Schaltverluste (typisch), IGBT, T1-T6

$E = f(R_G)$

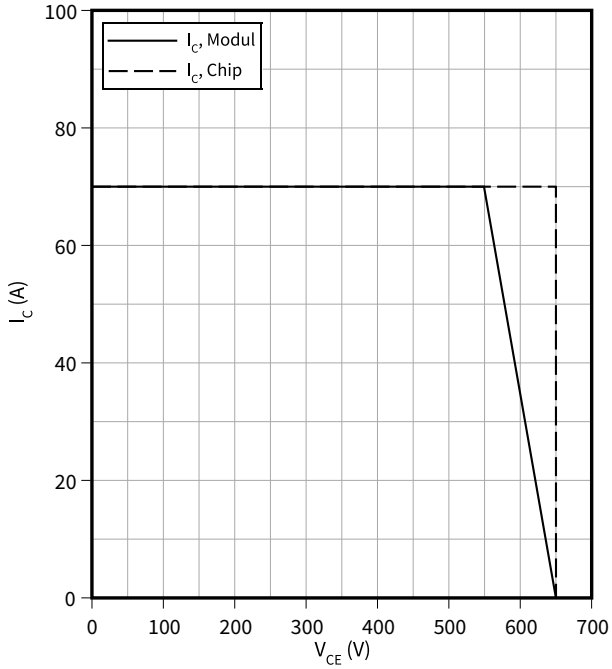
$I_C = 20\ A$, $V_{CC} = 350\ V$, $V_{GE} = -15 / 15\ V$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, T1-T6

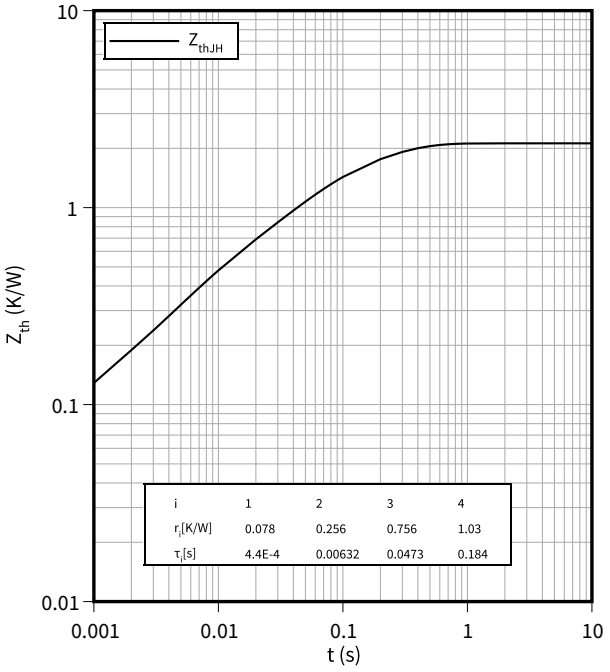
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 7.5\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



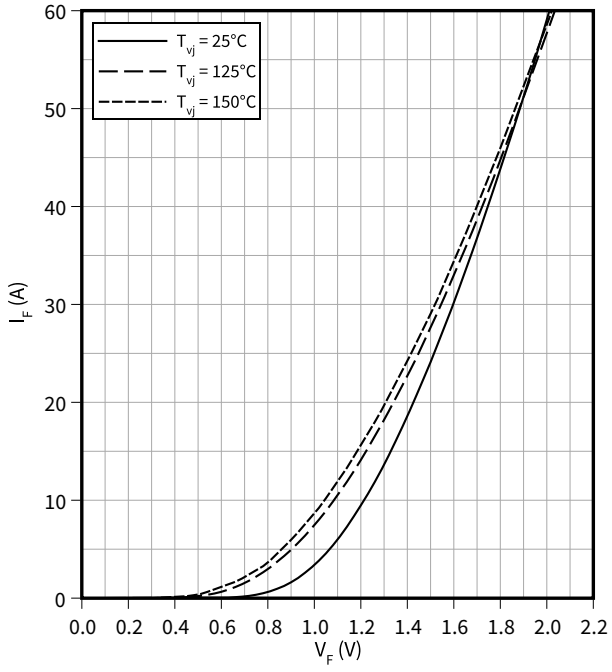
Transienter Wärmewiderstand , IGBT, T1-T6

$Z_{th} = f(t)$



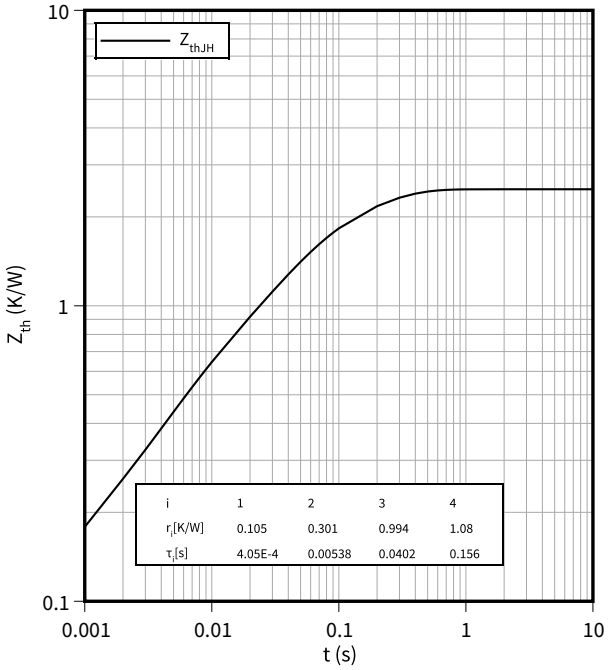
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D1-D6

$I_F = f(V_F)$



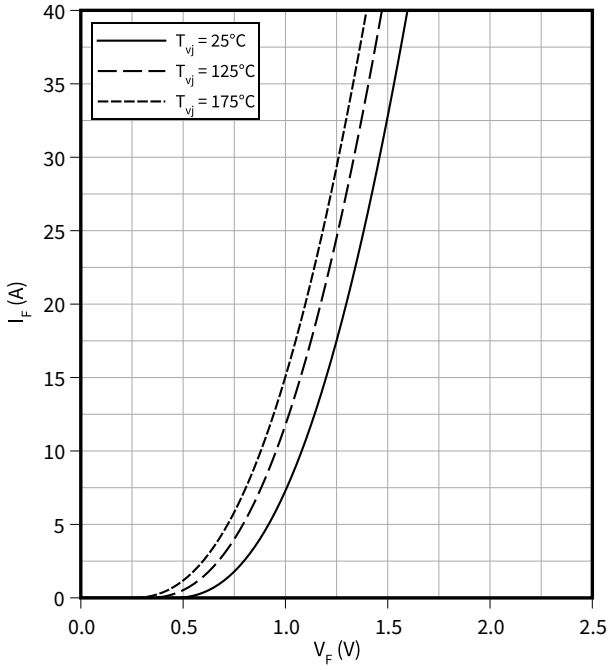
Transienter Wärmewiderstand, Diode, D1-D6

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D7-D12

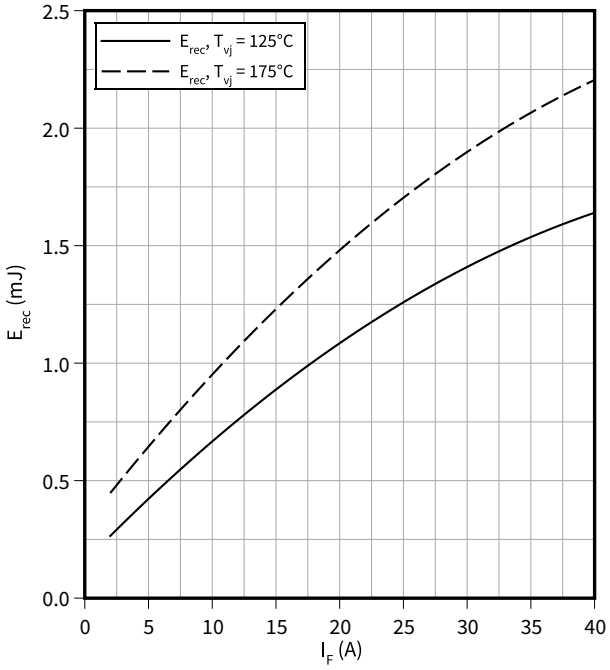
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, D7-D12

$E_{rec} = f(I_F)$

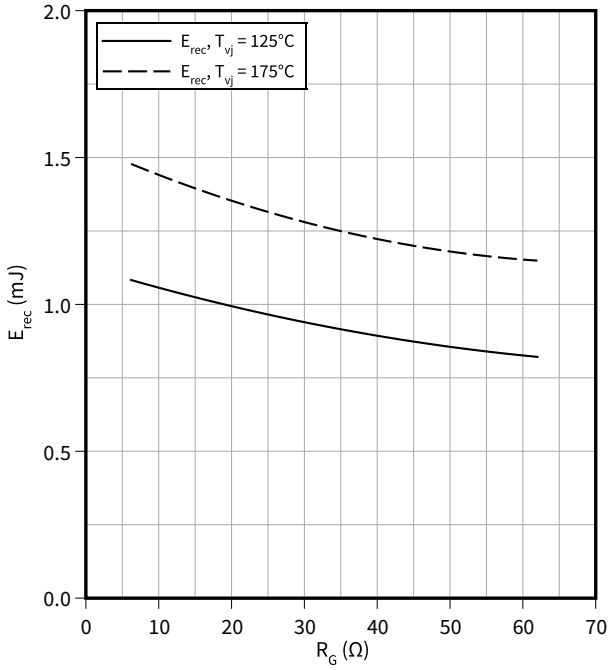
$R_{Gon} = 6.2\ \Omega$, $V_{CC} = 350\ V$



Schaltverluste (typisch), Diode, D7-D12

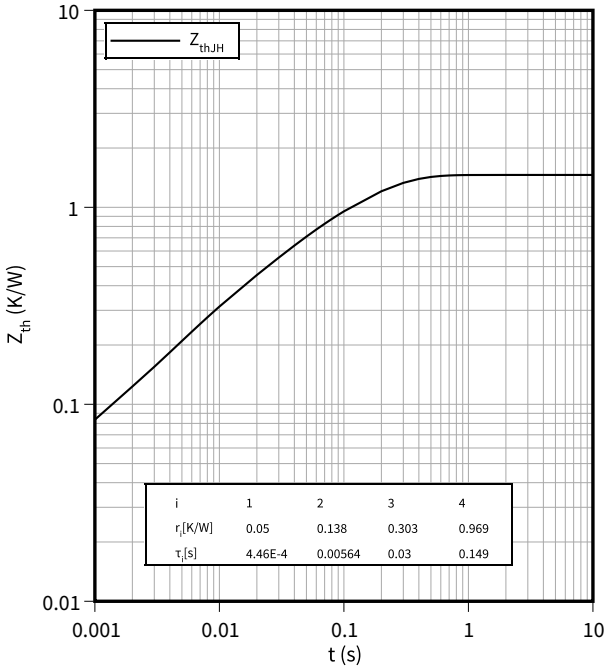
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 20\ A$, $V_{CC} = 350\ V$



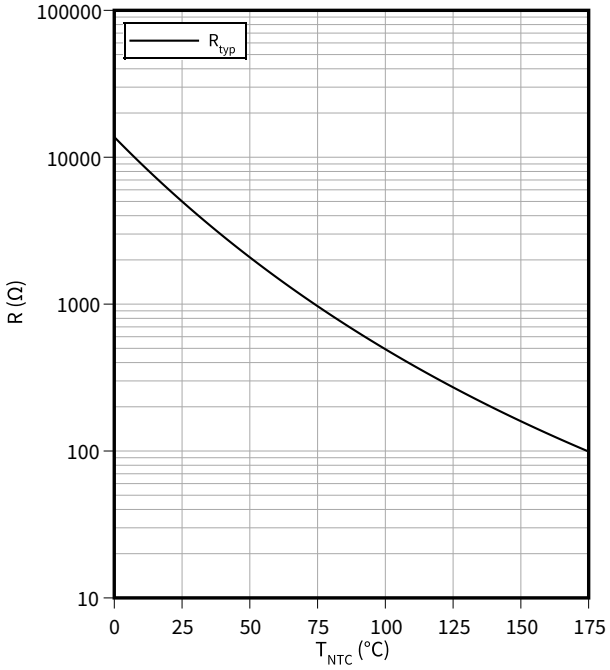
Transienter Wärmewiderstand, Diode, D7-D12

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



7 Schaltplan

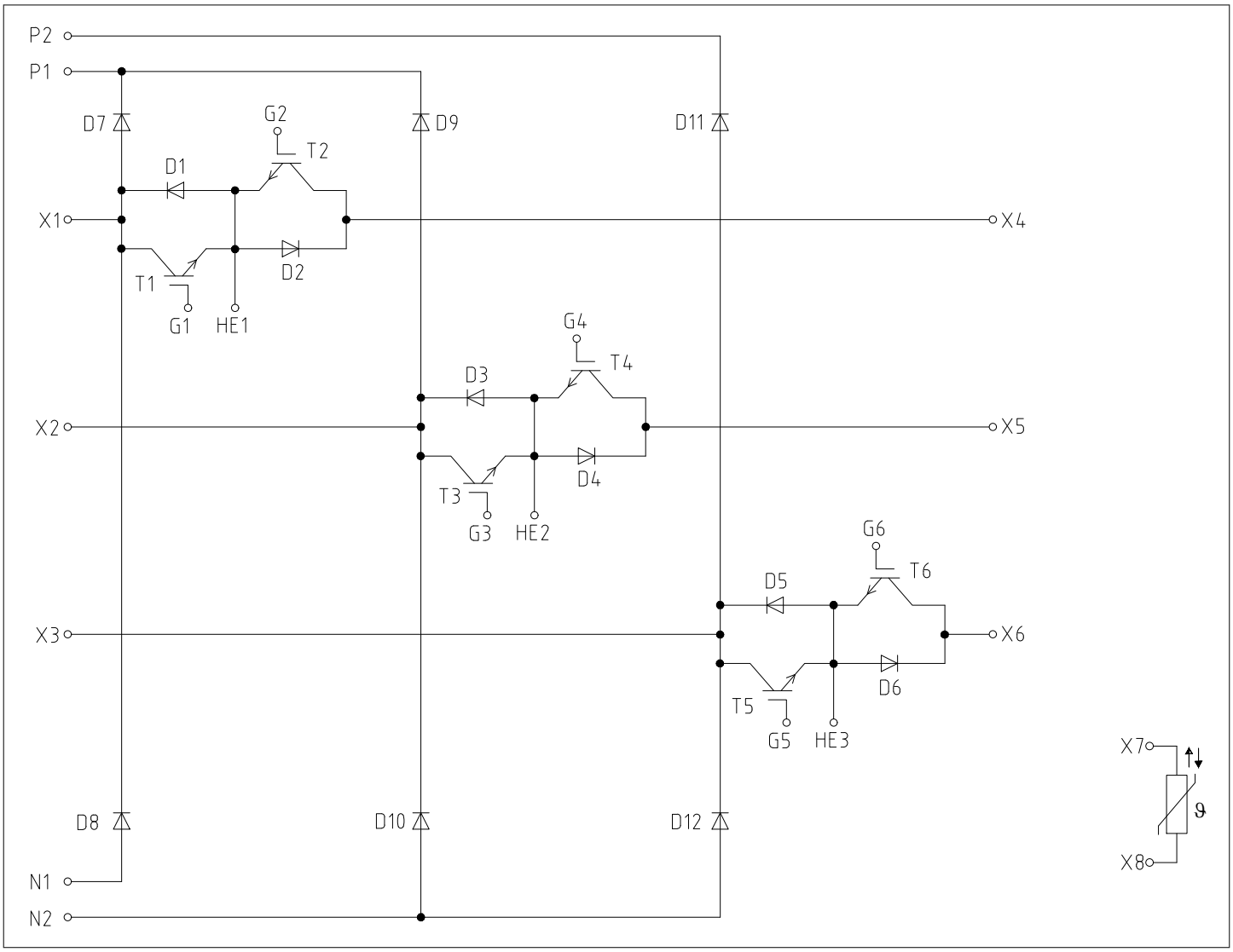


Abbildung 1

8 Gehäuseabmessungen

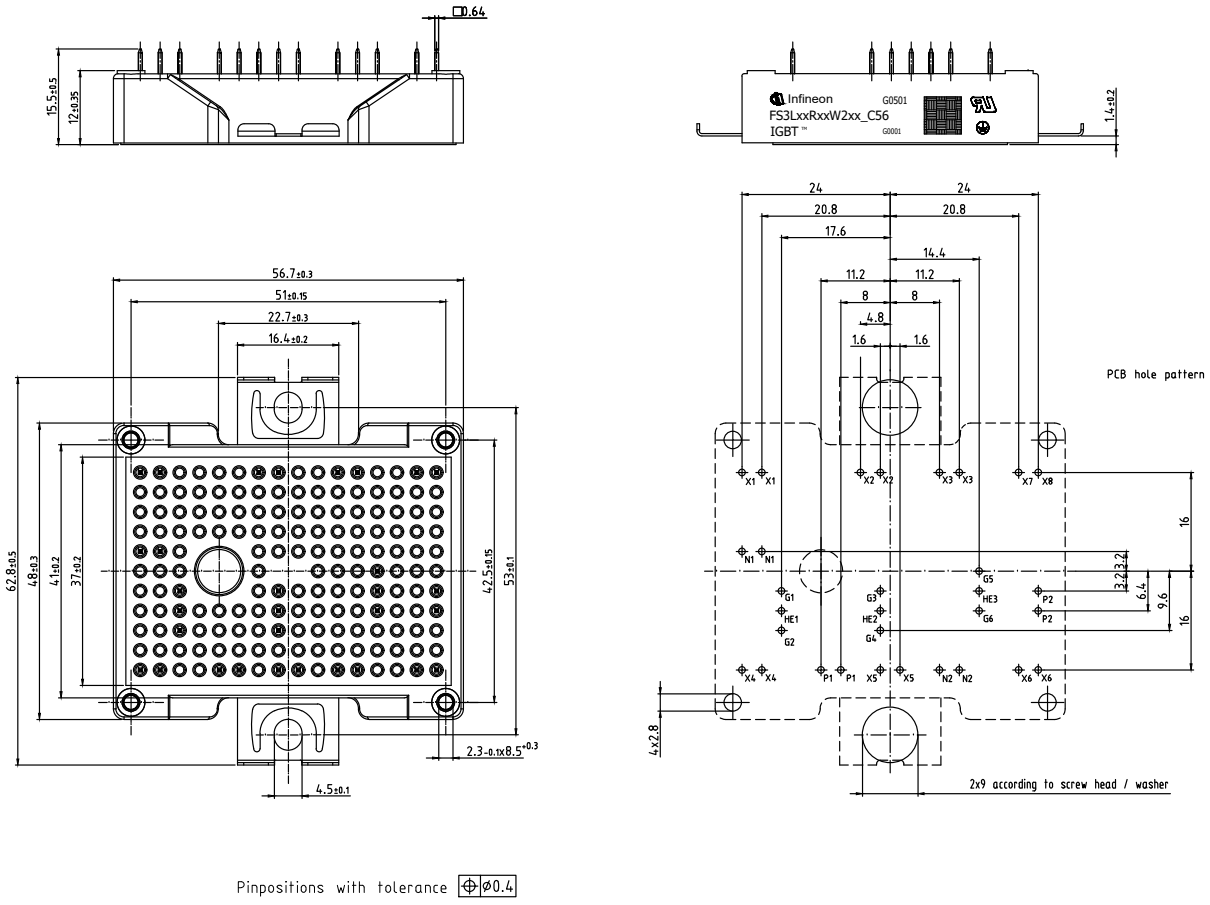


Abbildung 2

9 Modul-Label-Code

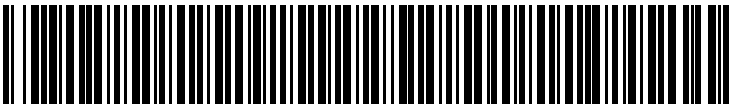
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 715491428465505499115 30	 715491428465505499115 30	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
1.00	2023-04-26	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-04-26

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABH341-001

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.